



S8050A (3DG8050A)

硅 NPN 半导体三极管/SILICON NPN TRANSISTOR

用途:用于乙类推挽功放。

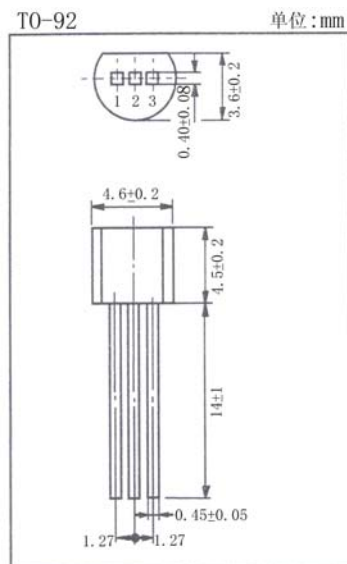
Purpose: Amplifier of portable radios in class B push-pull operation.

特点: P_c 、 I_c 大,与 S8550A (3CG8550A) 互补。

Features: High P_c , I_c , complementary pair with S8550A (3CG8550A).

极限参数/Absolute maximum ratings($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	40	V
V_{CE0}	25	V
V_{EB0}	6.0	V
I_c	800	mA
I_B	200	mA
P_c	625	mW
T_j	150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$



引脚: 1. E 2. C 3. B

电性能参数/Electrical characteristics($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_c=0.1\text{mA}$ $I_E=0$	40			V
V_{CE0}	$I_c=2.0\text{mA}$ $I_B=0$	25			V
V_{EB0}	$I_E=0.1\text{mA}$ $I_c=0$	6.0			V
I_{CB0}	$V_{CB}=35\text{V}$ $I_E=0$			0.1	μA
I_{EB0}	$V_{EB}=6.0\text{V}$ $I_c=0$			0.1	μA
$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=1.0\text{V}$ $I_c=100\text{mA}$	85		300	
$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=1.0\text{V}$ $I_c=500\text{mA}$	40			
$h_{FE(3)}$	$V_{CE}=1.0\text{V}$ $I_c=5.0\text{mA}$	45			
$V_{CE(sat)}$	$I_c=500\text{mA}$ $I_B=50\text{mA}$		0.28	0.6	V
$V_{BE(sat)}$	$I_c=500\text{mA}$ $I_B=50\text{mA}$		0.98	1.2	V
V_{BE}	$V_{CE}=1.0\text{V}$ $I_c=10\text{mA}$		0.66	1.0	V
f_T	$V_{CE}=10\text{V}$ $I_c=50\text{mA}$	100	190		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}$ $I_E=0$ $f=1.0\text{MHz}$		9.0		pF

$h_{FE(1)}$ 分档/ $h_{FE(1)}$ classifications: B: 85~160 C: 120~200 D: 160~300

